

2SD1557

NPN三重拡散形シリコントランジスタ カラーテレビ垂直偏向出力用

NPN Silicon Triple Diffused Transistor
Color TV Vertical Deflection Output

特長/FEATURES

- 高耐圧、大電流形であり h_{FE} のリニアリティが良い。
- 全損失が大きい。 $P_T=20$ W ($T_C=25$ °C)

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25$ °C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	200	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	$I_{C(DC)}$	2.0	A
コレクタ電流	$I_{C(pulse)}$ *	3.0	A
全損失	$P_T(T_c=25^\circ C)$	20	W
全損失	$P_T(T_a=25^\circ C)$	1.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C

*PW \leq 10 ms, Duty Cycle \leq 50 %

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25$ °C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	$I_C=500 \mu A, I_E=0$	200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$I_C=5 \text{ mA}, I_B=0, R_{BE}=\infty$	150			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	$I_E=500 \mu A, I_C=0$	5			V
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=150 \text{ V}, I_E=0$			50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=4 \text{ V}, I_C=0$			50	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10 \text{ V}, I_C=0.4 \text{ A}$	* 40	100	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500 \text{ mA}, I_B=50 \text{ mA}$	* 0.2	1.0		V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10 \text{ V}, I_C=0.4 \text{ A}$		10		MHz

*パルス測定 PW \leq 350 μs , Duty Cycle \leq 2 %
 h_{FE} 区分/M: 40~80 L: 60~120 K: 100~200